

Эффект скачковой диффузии изотопов гелия из образцов лунного грунта

© Г.С. Ануфриев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anufriev.massl@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 29 декабря 2009 г.
В окончательной редакции 29 марта 2010 г.)

Подробно исследован эффект диффузии изотопов гелия из образца лунного грунта (навеска 3.3 mg, фракция крупности $< 74 \mu\text{m}$, глубина отбора пробы 118 см в колонке длиной 1.6 m грунта, доставленного автоматической станцией Луна-24). Исследования проводились методом ступенчатого нагрева в диапазоне температур 300–1000°C и масс-спектрометрического изотопного анализа гелия, выделенного на каждой температурной ступени. Показано, что диффузия не подчиняется закономерностям Фика, что связано с большим числом радиационных нарушений в кристаллах минералов лунного грунта, а описывается формализмом, принятым для скачковой диффузии. Получено, что энергия активации диффузии для обоих изотопов гелия (^4He и ^3He) одинакова и равна 0.5 eV, а частотный фактор равен соответственно 0.51 и 0.59 s^{-1} . Случайные ошибки σ определения этих параметров примерно равны 5%. Доставленный лунный грунт во время земного хранения теряет гелий. Один грамм исследованного лунного материала в начале хранения при комнатной температуре ежесекундно теряет около $3 \cdot 10^9$ атомов гелия. Обнаружен сильный изотопный эффект скачковой диффузии гелия: легкий изотоп ^3He теряется в существенно большей мере. Чтобы устранить потери гелия, сопровождаемые фракционированием изотопов, доставляемый лунный грунт необходимо хранить при низкой температуре.

Исследования выполнены в рамках проекта ОФН IV.15 РАН.

1. Введение

Солнечный ветер — солнечная плазма, излучаемая Солнцем, достигает поверхности планет и их спутников, если они не защищены собственным магнитным полем. На Луне отсутствует магнитное поле, поэтому ионы солнечного ветра участвуют в процессе имплантации и вместе с космическими лучами создают многочисленные радиационные нарушения в лунных породах. Причем эти нарушения накапливаются в течение многих миллионов лет [1]. В [2] было отмечено, что в минералах с радиационными повреждениями диффузия инертных газов не подчиняется законам Фика. Впоследствии было показано [3] существование радиационно-стимулированной (скакковой) диффузии, параметры которой существенно отличаются от параметров равновесных законов Фика. Так как диффузия атомов в твердых телах — одно из фундаментальных явлений, на понимании которого базируется описание различных атомных процессов в кристаллах, а также многие технологические операции (ядерная энергетика, порошковая металлургия, полупроводники, наноматериалы и др.), это явление требует углубленного изучения с точки зрения скачкового механизма диффузии.

При изучении процесса выделения инертных газов из природных минералов [4] было обнаружено, что невыполнение диффузионных закономерностей Фика объясняется тем, что кристаллическая структура природных кристаллов далека от идеальной, так как содержит радиационные нарушения (в результате паспада примес-

ных урана и тория), и для покидания минерала атому инертного газа достаточно сделать несколько скачков. Это факт скачковой (малоскачковой) диффузии был исследован в основном на примере аргона [2,4].

Впоследствии скачковый механизм диффузии (вакансий) наблюдался в смешанных щелочно-галоидных кристаллах [5]. В других случаях исследований диффузии скачковый механизм не находил подтверждения [6]. В последнее время исследования закономерностей диффузии в системах гелий—твердое гело проводятся достаточно широко и могут быть полезны при изучении процесса динамической диффузии [7] гелия в различные типы твердых тел, при исследовании зернограничной диффузии [8], а также при конструировании и выборе материалов для ядерной энергетики [9,10].

В исследованиях диффузионных процессов лунный грунт интересен также тем, что он в течение длительного времени (миллионы лет) облучается солнечным ветром [1], ионы которого имеют энергию $\sim 1 \text{ keV}$ на нуклон, солнечными космическими лучами с энергией $\sim 10 \text{ MeV}$ на нуклон и галактическими космическими лучами с широким спектром энергий с максимумом в районе $\sim 10 \text{ GeV}$. Причем самая энергетичная часть космического излучения многократно превышает энергию ускоренных ионов, достижимую при помощи современных ускорителей. Основной состав упомянутых типов излучения — это ядра водорода. Гелий по распространенности находится на втором месте [11]. Гелий солнечного ветра сильно отличается по изотопному составу от земного гелия, так как содержит на много

порядков больше легкого изотопа ^3He . Это позволяет при исследовании процесса имплантации солнечных корпускул в лунные породы исследовать закономерности имплантации химически нейтрального солнечного гелия и таким образом абстрагироваться от химизма, сопровождающего процесс имплантации, а также не учитывать контаминацию солнечного гелия земным гелием. На орбите Земли поток самого распространенного корпускулярного излучения — солнечного ветра — составляет очень большую величину $\sim 2 \cdot 10^8 \text{ 1/cm}^2 \cdot \text{s}$. Поэтому априори можно ожидать, что атомный механизм процесса диффузии будет определяться наличием большого количества радиационных нарушений, а присутствие в лунном грунте набора минералов с различными кристаллическими решетками будет играть подчиненную роль. Иными словами, лунный грунт поведет себя по отношению к диффундирующему атомам гелия как квазиоднородное твердое тело. С другой стороны, появляется возможность исследовать одновременно диффузию атомов двух изотопов гелия, различающихся примерно на 30% по массе (и в $\sim 10^4$ раз по обилию в лунном грунте), что позволяет надеяться на обнаружение изотопного эффекта в явлении диффузии. Такие исследования по данным автора ранее также не проводились.

2. Материалы и методики

При исследовании образцов лунного грунта с большим сдвигом во времени (~ 24 года) были обнаружены [12] большие диффузионные потери гелия и фракционирование изотопов (уменьшение со временем изотопного отношения $^3\text{He}/^4\text{He}$), произошедшие в земных условиях за время хранения образцов при комнатной температуре. Эти результаты, усредненные по количеству исследованных образцов, приведены в таблице.

Учитывая многолетнее интенсивное облучение лунного грунта *in situ*, можно предположить, что диффузионные потери гелия в земных условиях при относительно низкой температуре примерно $+20^\circ\text{C}$ есть результат наличия многочисленных радиационных повреждений в кристаллических решетках минералов, образующих лунный грунт. В соответствии с исследованиями [2,4] это позволяет применить для описания процесса потерять механизм, согласно которому атомы газа покидают минерал не в соответствии с классическими законами

Усредненные по количеству измерений* результаты изотопных исследований образцов лунного грунта

Изотопы гелия	$^3\text{He} \cdot 10^6 \text{ cm}^3/\text{g}$	$^4\text{He} \cdot 10^2 \text{ cm}^3/\text{g}$	$(^3\text{He}/^4\text{He}) \cdot 10^4$
Годы	1982	2006	1982
Результаты измерений	36.3	9.59	2006 3.14 3.46 2.99

* В 1982 г. исследовано четыре образца, в 2006 г. — пять образцов.

диффузии [13,14], а в соответствии с закономерностью скачковой диффузии [4].

Для получения количественной оценки параметров этой разновидности диффузии использован ступенчатый нагрев образца лунного грунта (навеска 3.3 mg), фракция $< 74 \mu\text{m}$.

Процедура предполагает нагрев образца в вакууме. Метод ступенчатого нагрева успешно применяется в разноплановых изотопных исследованиях, например [15]. В нашем случае нагрев производился в диапазоне $300\text{--}1000^\circ\text{C}$ через 100°C с выдержкой постоянной температуры на каждой ступени в течение 0.5 h. Процесс выделения изотопов гелия He во времени t можно описать выражением [4]

$$\frac{d\text{He}}{dt} = -v\text{He}, \quad (1)$$

где частота „скакков“ v зависит от энергии активации E и температуры T

$$v = v_0 \exp\{-E/kT\}, \quad (2)$$

k — постоянная Больцмана.

Решая уравнение (1), получим

$$\text{He}_i = \text{He}_0 \exp(-vt), \quad (3)$$

где He_0 — исходная концентрация какого-либо изотопа гелия в образце, He_i — оставшийся в образце гелий спустя интервал времени t .

3. Результаты исследований и обсуждение

Полученные выражения позволяют определить основные параметры скачковой диффузии обоих стабильных изотопов гелия: энергии активации и частотные факторы. Подставив выражение (2) в (3) и прологарифмировав результат 2 раза, получим в координатах $\ln \ln$ и T^{-1} уравнение наклонной прямой линии

$$\ln \ln(\text{He}_0/\text{He}_i) = \ln(v_0 t) - E/kT, \quad (4)$$

которое позволяет по экспериментальным данным ступенчатого отжига лунного образца (рис. 1) получить величины параметров диффузии. При этом использовались данные для ^4He . Найдено: $E = 0.5 \text{ eV}$ и частотный фактор $v_{04} = 0.51 \text{ s}^{-1}$. Заметим, что величина $t = 0.5 \text{ h}$, используемая в (4), постоянна и задана режимом температурных ступеней в нашем эксперименте. Расчетная наклонная линия на рис. 1 хорошо согласуется с экспериментальными точками. Абсолютная величина коэффициента корреляции равна 0.995. Вычисление параметров диффузии сделано на основании данных о кинетике выделения изотопа ^4He , а не ^3He , так как ошибки измерения концентрации основного изотопа ^4He существенно меньше. График по данным для изотопа ^3He аналогичен

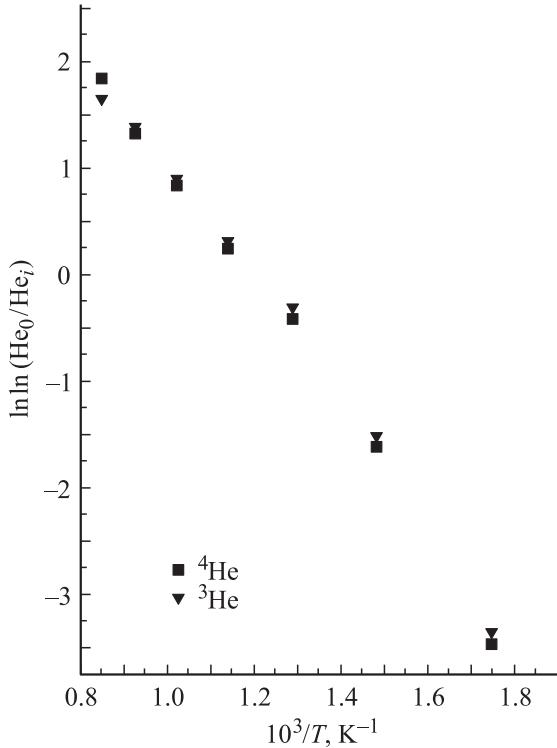


Рис. 1. Зависимость изменения концентрации изотопов гелия от величины обратной температуры образца при его ступенчатом нагреве в вакууме. Остаточное давление в масс-анализаторе масс-спектрометра $\sim 10^{-8}$ Торр.

и практически неотличим от такового для ${}^4\text{He}$ (рис. 1). Поэтому энергия активации для этого изотопа в пределах экспериментальных ошибок ($\sigma < 5\%$) равна энергии активации изотопа ${}^4\text{He}$, т.е. $E = 0.5\text{ eV}$. Частотный фактор для ${}^3\text{He}$ можно определить исходя из модели разделения компонентов бинарной смеси согласно [16] с использованием экспериментальных данных о фракционировании изотопов. Возможно также применение теоретической модели, согласно которой отношение частотных факторов для диффундирующих изотопов [14] обратно пропорционально корню квадратному из отношения масс изотопов. Оба подхода к определению частотного фактора для изотопа ${}^3\text{He}$ поддерживают друг друга, так как приводят к одинаковому результату. Частотный фактор легкого изотопа гелия ${}^3\text{He}$ равен $\nu_{03} = 0.59\text{ s}^{-1}$, т.е. заметно отличается от частотного фактора для тяжелого изотопа ${}^4\text{He}$ $\nu_{04} = 0.51\text{ s}^{-1}$.

Полученные параметры процесса диффузии позволяют рассчитать величину потерь гелия лунным грунтом в зависимости от температуры и срока хранения лунного грунта t

$$\text{He}_0 = \text{He}_i \exp[\nu_0 t \exp(-E/kT_i)]. \quad (5)$$

Здесь T_i — температура хранения образца, остальные обозначения прежние. Нормированные графики изменения коэффициента сохранности He_i/He_0 в логарифмическом масштабе для комнатной температуры $+20^\circ\text{C}$

и рекомендуемой температуре хранения грунта -20°C приведены на рис. 2.

Расчет показывает, что с 1982 по 2006 г., т.е. за 24 года, потери гелия при температуре хранения грунта $+20^\circ\text{C}$ составили заметную величину: $\text{He}_i/\text{He}_0 = 2.6$, что согласуется с экспериментальными данными, приведенными в таблице. Концентрация ${}^4\text{He}$ в образцах за 30 лет хранения с момента доставки в 1976 г. лунного грунта уменьшилась в 3.5 раза. Сохранность гелия можно значительно повысить (рис. 2), снизив несколько температуру хранения образцов до -20°C .

Из уравнения (4) можно получить выражение, описывающее поведение изотопного отношения гелия в зависимости от температуры T образца и срока t его хранения при данной температуре,

$$({}^3\text{He}/{}^4\text{He})_i : ({}^3\text{He}/{}^4\text{He})_0 = \exp(-\Delta\nu t \exp(-E/kT)), \quad (6)$$

где индексы i и 0 обозначают текущее и стартовое значения изотопного отношения, $\Delta\nu = \nu_{03} - \nu_{04} = 0.08$ — разность частотных факторов изотопов гелия. Графики изменения изотопных отношений, характеризующие процесс фракционирования изотопов гелия для двух температур, $+20$ и -20°C , приведены на рис. 3 в полулогарифмических координатах. Они показывают наличие

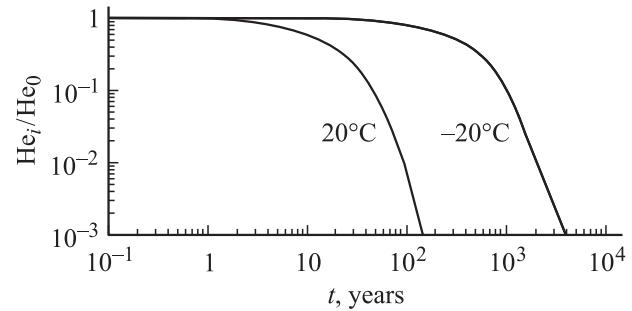


Рис. 2. Графики, иллюстрирующие сохранность изотопа ${}^4\text{He}$ в образцах лунного грунта во времени в зависимости от температуры. Для изотопа ${}^3\text{He}$ аналогичные графики имеют такой же вид.

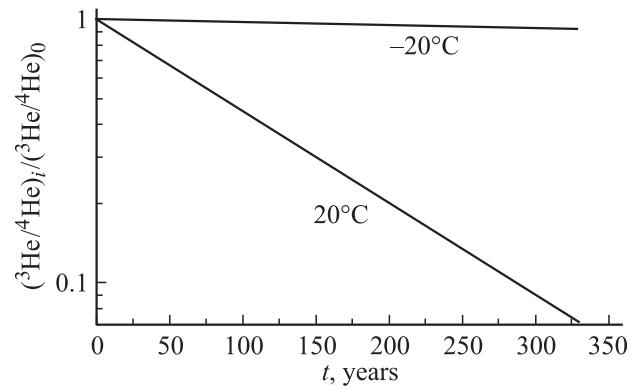


Рис. 3. Изменение фракционирования изотопов гелия в образце лунного грунта во времени при различных температурах.

преимущественных потерь легкого изотопа ^3He с течением времени, причем небольшое снижение температуры хранения образцов от комнатной +20 до -20°C очень существенно уменьшает темп фракционирования.

Использованная методика наряду с сильными сторонами — получение несложных аналитических выражений для исследования основных зависимостей скачковой диффузии одновременно двух изотопов — имеет также недостаток, заключающийся в некоторой произвольности выбора величины длительности (во времени) температурных ступеней при ступенчатой нагреве образцов. Была выбрана типичная для изотопных исследований длительность 0.5 h главным образом потому, что результаты расчета по выражениям (5) и (6) с использованием этого временного интервала удовлетворительно совпадают с экспериментальными данными, представленными в таблице. Некоторое превышение экспериментальных данных над расчетными может быть связано с непостоянством температуры при длительном хранении и с ее отличием в среднем от температуры $+20^\circ\text{C}$, принятой в расчетах.

4. Заключение

Впервые обнаружен эффект быстрой диффузии макрокаличеств изотопов гелия из лунного грунта в условиях земного хранения. В частности, как следует из (5), один грамм исследованного лунного материала при комнатной температуре $+20^\circ\text{C}$ в начале хранения может терять каждую секунду около $3 \cdot 10^9$ атомов гелия. При этом процесс потерь гелия сопровождается процессом фракционирования изотопов. При комнатной температуре потери гелия в соответствии с той же формулой (5) происходят с характерным временем ~ 15 лет, по истечении которого концентрация гелия падает в 2 раза. Изотопное отношение при этом уменьшается только на $\sim 9\%$. Важно отметить, что изотопы гелия как результат имплантации солнечного ветра внедряются только в тонкий приповерхностный слой лунного грунта ($< 0.5 \mu\text{m}$) [17] и количество изотопов резко спадает по направлению к центру частиц грунта. Таким образом, наблюдаемая диффузия гелия из лунных частиц не поддерживается имеющимся градиентом его объемной концентрации. Следует отметить, что диффузия гелия, вероятнее всего, происходила одновременно с диффузией вакансий. Известно, что нагрев образца до 1000°C ведет к отжигу радиационных треков [18]. Проведенное исследование посвящено малоизученному явлению скачковой диффузии на примере образца лунного грунта. Полученные результаты полезны как дополнительная характеристика процесса диффузии в часто используемых в современных технологиях и методах анализа системах гелий–твердое тело. Прикладное значение полученных результатов может состоять также в том, что в ряде случаев ранее проведенные оценки содержания солнечного гелия в лунном реголите *in situ* на основа-

нии лабораторных измерений, не учитывающих потери, должны быть увеличены. Кроме того, можно предположить, что и другие летучие компоненты при земном хранении лунного грунта (при комнатной температуре) теряются также значительно (легкие особенно). Это обстоятельство необходимо учитывать также при количественной оценке изотопных составов непосредственно в солнечном излучении. Отсюда следует, что при новых поставках лунного грунта, чтобы предотвратить потери летучих компонентов, грунт необходимо хранить при низкой температуре.

Список литературы

- [1] Дж.Дж. Вассербург, Д.А. Папанастасиу, М.Т. Мак Каллок, Р.Ф. Димок, Д.Дж. Де Паоло, А.А. Чодос, А.Л. Олби. В кн.: Лунный грунт из Моря Кризисов. Наука, М. (1980). С. 219.
- [2] Э.К. Герлинг. Современное состояние аргонового метода определения возраста и его применение в геологии. Изд-во АН СССР, Л. (1961). 168 с.
- [3] В.А. Степанов. ЖТФ **68**, 8, 67 (1998).
- [4] И.М. Морозова, Г.Ш. Ашканиязде. Миграция атомов редких газов в минералах. Наука, Л. (1971). 184 с.
- [5] Л.Г. Горбич, А.Н. Вараксин. ФТТ **41**, 3, 431 (1999).
- [6] В.Г. Чудинов. ЖТФ **70**, 7, 133 (2000).
- [7] О.В. Клявин, Б.А. Мамырин, Л.В. Хабарин, Ю.М. Чернов. ФТТ **47**, 5, 837 (2005).
- [8] А.Р. Жиганов, А.Я. Купряжкин. ЖТФ **75**, 8, 63 (2005).
- [9] В.П. Чакин, С.В. Белозеров, О.А. Посевин. ФММ **104**, 3, 270 (2007).
- [10] М.А. Коваленко, А.Я. Купряжкин, В.В. Иванов. ЖТФ **80**, 1, 138 (2010).
- [11] В.С. Мурзин. Введение в физику космических лучей. Изд-во МГУ, М. (1988). 319 с.
- [12] Г.С. Ануфриев, Э.М. Галимов. ДАН **420**, 6, 805 (2008).
- [13] Я.И. Френкель. Введение в теорию металлов. Наука, М. (1950). 358 с.
- [14] Дж. Маннинг. Кинетика диффузии атомов в кристаллах. Мир, М. (1971). 280 с.
- [15] Г.С. Ануфриев, Б.С. Болтенков. ДАН **404**, 6, 802 (2005).
- [16] А.И. Бродский. Химия изотопов. Изд-во АН СССР, М. (1957). 596 с.
- [17] P. Eberhardt, J. Geiss, H. Graf, N. Grögler, U. Krähenbühl, H. Schwaller, J. Schwarzmüller, A. Stettler. In: Proc. Apollo 11 Lunar Sci. Conf. Houston (1970). V. 2. P. 1037.
- [18] K. Gallagher, R. Brown, C. Johnson. Ann. Earth Planet Sci. **26**, 1, 519 (1998).